
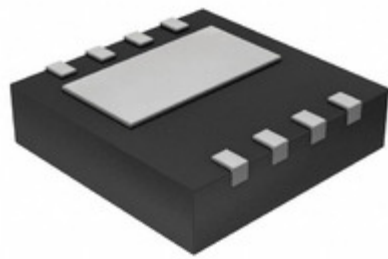

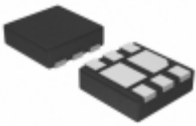
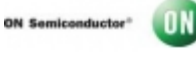
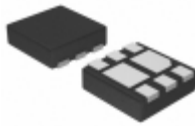

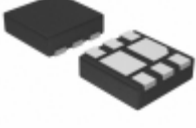

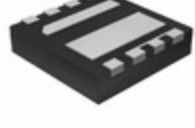
	<h2 style="color: red;">NTLTD7900ZR2G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTLTD7900ZR2G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 6A 8MICRO</p> <p>Datenblätter:  NTLTD7900ZR2G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 11122 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTLTD7900ZR2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 6A 8MICRO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	11122 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.5W
Verpackung / Gehäuse	8-VDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	Micro8™
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 6.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	15pF @ 16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTLTD7900ZR2G ist neu im Original, Suche NTLTD7900ZR2G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTLTD7900ZR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTLTD7900ZR2G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTLTD7900ZR2 ON NTLTD7900ZR2 ON</p>	 <p>NTLUD3191PZTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 1.1A 6UDFN</p>	 <p>NTLTD7900ZR AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTLTD7900ZR ON</p>	 <p>NTLUD3A260PZTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 1.3A UDFN6</p>
 <p>NTLTF4156NT ON ON QFN</p>	 <p>NTLUD3191PZTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 1.1A 6UDFN</p>	 <p>NTLTD7900NR2G ON NTLTD7900NR2G ON</p>	 <p>NTLUD4951NFTWG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 5.5A/6.3A WDFN8</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ 24AA00T-I/SN	➔ B72520V40M62	➔ CGA5L3X8R1C475K160AB	D CL05C330JB5NNNC	➔ CQ0805CRNPO0BN7R5
⊣ CR6L-30S	⚙ FDD6778A	D FOD817A3SD	➔ LT1641-2IS8	➔ NJM2856DL3-33
⚙ NTLGD3502NT1G	⊣ NTLGD3502NT2G	⚙ NTLJ3113PT1G	➔ NTLJD2105LTBG	➔ NTLJD3115PT1G
D NTLJD3115PTAG	⚙ NTLJD3119CT1G	⊣ NTLJD3119CTAG	⚙ NTLJD3119CTBG	➔ NTLJD4116NT1G
➔ NTLJF3117PT1G	➔ NTLJF4156NT1G	⚙ NTLJF4156NTAG	⊣ NTLJS2103P	➔ NTLJS2103PTAG
➔ NTLJS2103PTBG	➔ NTLJS3113P	D NTLJS3113PT1G	⚙ NTLJS3113PTAG	⊣ NTLJS3A18PZTWG
⚙ NTLJS4114NT1G	D NTLJS4114NTAG	➔ NTLUD3113PT1G	➔ NTLUD3113PTAG	➔ NTLTD7900NR2G
⊣ NTLTD7900ZR2	⚙ NTLUD3A260PZTAG	➔ NTLUD3A50PZTAG	➔ NTLUD3A50PZTAG	➔ NTLUS3A18PZTAG
⚙ NTLUS3A40PZTAG	⊣ NTLUS3A40PZTBG	⚙ NTLUS3A90PZTAG	D NTLUS4930NTAG	➔ RT9030-14GU5
➔ SKD31/04	⚙ SKIIP319PSS065T1E	⊣ ST330S14P3L	⚙ VI-231-MY	➔ VR25000001004FA100

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited